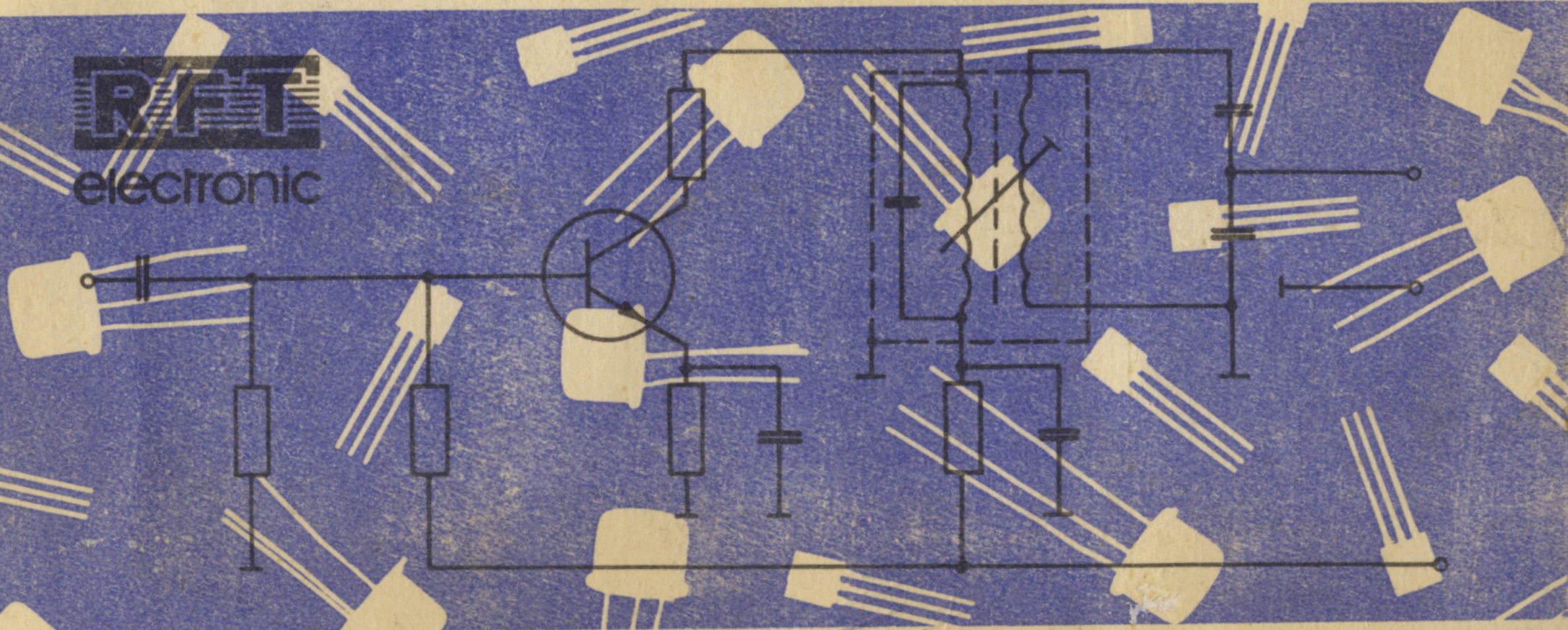


# HALBLEITER

**RET**  
electronic



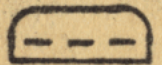
# BASTLERBEUTEL 9

Inhalt:

- a) 5 Stück Miniplasttransistoren  
(für geregelte ZF-Stufen)
- b) 5 Stück Miniplasttransistoren  
(für ungeregelte ZF-Stufen)
- c) 2 Stück Silizium-npn-Transistoren  
(für höhere Betriebsspannungen)

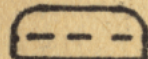
Anschlußschema:

Farbpunkt



B E C

a



B E C

b



E B C

c

Daten der Transistoren:

a), b)

Reststrom	$I_{CBO}$	$\hat{=}$	500 nA	bei $U_{CB} = 20$ V
Durchbruchsspannung	$U_{(BR)CEO}$	$\hat{=}$	12 V	bei $I_C = 1$ mA
Stromverstärkung	$h_{21E}$	$\hat{=}$	5	bei $U_{CE} = 5$ V
				$I_C = 10$ mA

c)

Reststrom	$I_{CBO}$	$\hat{=}$	100 nA	bei $U_{CB} = 100$ V
Reststrom	$I_{CER}$	$\hat{=}$	5 mA	bei $U_{CER} = 100$ V
Stromverstärkung	$h_{21E}$	$\hat{=}$	8	$R_{BE} = 1$ kOhm
				bei $U_{CE} = 10$ V
				$I_C = 5$ mA

### Hinweise:

Die im Bastlerbeutel enthaltenen Miniplasttransistoren sind speziell für den Einsatz im geregelten und ungeredelten ZF-Verstärker für Frequenzen bis etwa 40 MHz vorgesehen. Gute Ergebnisse kann man auch bei anderen Anwendungen bis 200 MHz erzielen:

- z.B. :
- Mischstufen
  - Breitbandverstärker für UKW
  - Treiberstufen für Transistorsender

Diese Transistoren sind in Emitterschaltung einzusetzen.

Die metallverkappten Si-Transistoren können in Videostufen und Regelnetzteilen für höhere Spannungen eingesetzt werden.

## Halbleiter - Bastlerbeutel - Sortiment

- |   |            |
|---|------------|
| 1 <u>NF-Schaltungen</u><br>Inhalt: 14 NF-Transistoren   | 50-400 mW  |
| 2 <u>HF-Schaltungen</u><br>Inhalt: 10 HF- und UKW-Transistoren  |            |
| 3 <u>NF-Leistungstransistor-Schaltungen</u><br>Inhalt: 5 NF-Leistungstransistoren   | 1- 10 W    |
| 4 <u>Gleichrichterdiode</u><br>Inhalt: 12 Ge- bzw. Si-Gleichrichterdiode  | 0,1- 1 A   |
| 5 <u>Leistungsgleichrichterdiode</u><br>Inhalt: 4 Si-Leistungsgleichrichterdiode  | 10 A       |
| 6 <u>Si-Miniplasttransistoren</u><br>Inhalt: 20 HF- und Schalttransistoren  | 200 mW     |
| 7 <u>Si-Transistoren im Metallgehäuse</u><br>Inhalt: 12 HF- und Schalttransistoren  | 300-600 mW |
| 8 <u>Digitale Integrierte Schaltkreise</u><br>Inhalt: 8 Integrierte Schaltkreise für die<br>Anwendung in der Digitaltechnik |            |



**KOMBINAT VEB HALBLEITERWERK FRANKFURT (ODER)**  
**STAMMBETRIEB**

**BETRIEBSTEIL KONSUMGÜTER**